

## ДИСКУССИИ

УДК 535.39-14

О РЕЗОНАНСНОМ МЕТОДЕ ИЗМЕРЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  
ОТРАЖЕНИЯ НЕПРОЗРАЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В СУБМИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ ВОЛН

B. B. Мериакри и E. F. Ушаткин

В работе [1] описана резонансная методика измерения модуля  $\sqrt{R}$  и фазы  $\varphi$  коэффициента отражения от поверхности диэлектрического образца на субмиллиметровых волнах. С помощью этой методики в [1, 2] измерялись температурные зависимости  $R$  и  $\varphi$  кристаллов KDP.

Однако в [1] в формуле для набега фазы  $\Theta$  волны в резонаторе допущена ошибка, приводящая к неверному определению  $\varphi$ . Правильное выражение для  $\Theta$  имеет вид

$$\Theta = \frac{4\pi d}{\lambda} + \varphi_0 + \varphi, \quad (1)$$

т. е. в [1, 2] значения  $\varphi$  (а при относительных измерениях изменения  $\varphi$ ) занижены в два раза.

Кроме того, приведенные в [1, 2] погрешности измерения ( $\Delta R/R < 1\%$ ,  $\Delta\varphi = 0.1^\circ$ ) нам представляются заниженными по следующим причинам.

1. В формуле для коэффициента отражения от резонатора ( $R_p$ ) необходимо учитывать паразитные отраженные и рассеянные линзами, диафрагмами и другими элементами измерительного тракта волны. Известно (см., например, [3, 4]), где по аналогичной методике определялись потери в волноводном резонаторе), что указанные паразитные волны принципиально ограничивают точность измерений.

Считая паразитные волны плоскими, а их амплитуды  $\sqrt{R_k}$  ( $k = 1, 2, \dots$ ) малыми по сравнению с амплитудой падающей волны, можно записать коэффициент отражения системы в виде

$$R_p^* = |\sqrt{R_p} + \sum_k \sqrt{R_k} \exp(i\psi_k)|^2, \quad (2)$$

где  $R_p$  то же, что в [1] с учетом (1),  $\psi_k$  — разности фаз паразитных и отраженной от резонатора волн.

Чем меньше  $R_p$ , тем существеннее влияние паразитных волн на измеряемую величину  $R_p^*$ . При величине  $R_p$ , сравнимой с уровнем паразитных волн, формула для расчета погрешностей, приведенная в [1], перестает быть справедливой. С другой стороны, из (2) следует, что величина резонансного минимума  $R_{\text{рим.}}^*$  и его положение на оси длин волн ( $\lambda_{\text{мин.}}$ ) не являются однозначными функциями  $R$  и  $\varphi$ , т. е. измеренным значениям  $R_{\text{рим.}}^*$  и  $\lambda_{\text{мин.}}$  соответствует область значений  $R$  и  $\varphi$  в зависимости от случайных параметров  $R_k$  и  $\psi_k$ . Связанные с этим погрешности (при  $k=1$ ,  $R_{\text{рим.}}^* = 0$ ) равны:

$$\frac{\Delta R}{R} = \pm 2 \frac{1 - R_0}{\sqrt{R_0}} \sqrt{R_1}, \quad (3)$$

$$\Delta\varphi = \pm \frac{1 - R_0}{\sqrt{R_0}} \sqrt{R_1}. \quad (4)$$

Причем если минимальна погрешность измерения  $\varphi$ , то максимальна —  $R$ , и наоборот.

В [1] отмечалось, что лишь при определенных условиях минимум  $R_p^*$  составлял  $10^{-4}$  от максимального и определялся паразитными переотражениями от элементов квазиптического тракта, т. е., как видно из (2), уровень паразитных волн по крайней мере больше  $10^{-4}$ . Тогда из (3), (4) получаем ( $R_0=0.4$ ):  $\Delta R/R > 1.9\%$ ,  $\Delta\varphi > 0.54^\circ$ , что существенно превышает приводимые в [1, 2] значения.

2. Кроме рассмотренного в п. 1 источника погрешностей, следует, на наш взгляд, учесть пространственную неоднородность толщины резонатора (малые перекосы образца

и решетки, неплоскость последней) что приводит к увеличению резонансного минимума и расширению резонансной кривой; частотную дисперсию  $DR_0$  и  $\varphi_0$  решетки [5, 6]; тепловое расширение кварцевых шайб и проволочек решетки; дискретность измерения частоты генератора.

Таким образом, необходимы уточнение погрешностей методики [1] и соответствующая корректировка результатов измерений  $R$  и  $\varphi$  исследованных в [1, 2] кристаллов.

### Литература

- [1] А. А. Волков, Н. А. Ирисова, Г. В. Козлов. Опт. и спектр., 40, 386, 1976.
- [2] А. А. Волков, Н. А. Ирисова, Г. В. Козлов, Ю. В. Шалдин. Изв. АН СССР, сер. физ., 39, 836, 1975.
- [3] Ю. Н. Казанцев, В. В. Мериакри. Радиотехника и электроника, 4, 131, 1959.
- [4] Ю. Н. Казанцев. Радиотехника и электроника, 6, 241, 1961.
- [5] А. М. Сивов. Радиотехника и электроника, 6, 483, 1961.
- [6] Л. А. Вайнштейн. Электродинамика больших мощностей, сб. 2. Изд. АН СССР, М., 1963.

Поступило в Редакцию 3 мая 1976 г.

УДК 535.39

## ПО ПОВОДУ ПИСЬМА В. В. МЕРИАКРИ И Е. Ф. УШАТКИНА

A. A. Волков, Н. А. Ирисова и Г. В. Козлов

В работах [1, 2] дано описание предложенного нами метода определения диэлектрических характеристик поглощающих веществ, основанного на измерении модуля  $\sqrt{R}$  и фазы  $\varphi$  коэффициента отражения исследуемого образца. В измерениях регистрируется сигнал, отраженный от открытого резонатора, задним зеркалом которого является плоская поверхность образца, а в качестве переднего полупрозрачного зеркала используется проволочная сетка с хорошо известными параметрами. Полученные в эксперименте характеристики резонатора — резонансная частота и добротность — позволяют судить о свойствах его зеркал, т. е. рассчитать диэлектрические параметры образца.

Данный метод позволяет изучать вещества с практически сколь угодно большими коэффициентами поглощения и это, по нашему мнению, открывает, например, новые возможности для исследования температурных зависимостей диэлектрических характеристик сегнетоалентриков в особенности при температурах, близких к фазовым переходам.

Однако в формуле для определения  $\Delta\varphi$  образца нами была допущена ошибка, что привело к завышенным результатам в определении  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$  кристалла KDP при сохранении общего вида их температурных зависимостей.

Что же касается замечаний авторов письма относительно точностей определения  $R$  и  $\varphi$ , то они, по-видимому, основаны на недоразумении. Авторы письма выбрали для своих оценок весьма неблагоприятную ситуацию, когда наряду с полезным сигналом на приемник попадает равный ему по величине паразитный сигнал. При этом разбирается случай, далеко не самый удачный для применения резонаторного метода, когда измеряемый коэффициент отражения сравнительно мал ( $R \sim 0.4$ ). Даже в этих условиях, как видно из письма, резонаторный метод приводит к вполне приемлемым точностям в определении  $R$  и  $\varphi$  ( $\sim 2\%$  для  $R$  и  $\sim 0.5^\circ$  для  $\varphi$ ), которые в большинстве случаев едва ли могут быть получены с помощью более простых прямых измерений  $T$  и  $R$ . Но главное состоит в том, что при измерениях предложенным резонаторным методом вовсе нет необходимости работать с предельно малыми уровнями полезного сигнала. Варьируя параметры переднего сетчатого зеркала, т. е. выбирая сетки с нужным  $R_e$ , можно в широких пределах изменять глубину резонансного минимума и тем самым делать его удобным для регистрации. В наших работах, как правило, глубина минимума изменялась в пределах  $10^{-3}$ — $10^{-2}$ . В то же время нами всегда уделялось внимание устранению паразитного излучения, уровень которого в любых экспериментах не превышал  $10^{-4}$ .

### Литература

- [1] А. А. Волков, Н. А. Ирисова, Г. В. Козлов. Опт. и спектр., 40, 386, 1976.
- [2] А. А. Волков. Автореф. канд. дисс., ФИАН, 1975.

Поступило в Редакцию 15 декабря 1976 г.